

产品目录

存储器

2023



特点	系列	页
串行EEPROM (SPI, I²C, Microwire)		
2线 串行E ² PROM	S-24C02D/04D/08D/16D	5-3
2线 串行E ² PROM	S-24C32C/64C	5-4
2线 串行E ² PROM	S-24C128C	5-4
2线 串行E ² PROM	S-24C256C	5-5
2线 串行E ² PROM	S-24C512C	5-5
2线 串行E ² PROM	S-24CM01C	5-6
SPI 串行E ² PROM	S-25C010A/020A/040A	5-6
SPI 串行E ² PROM	S-25C080A	5-7
SPI 串行E ² PROM	S-25C160A	5-7
SPI 串行E ² PROM	S-25C320A/640A	5-8
SPI 串行E ² PROM	S-25C128A	5-8
SPI 串行E ² PROM	S-25C256A	5-9
SPI 串行E ² PROM	S-25C512A	5-9
SPI 串行E ² PROM	S-25CM01A	5-10
3线 串行E ² PROM	S-93C46C/56C/66C/76C/86C	5-10
EEPROM for DIMM (SPD)		
2线串行E ² PROM用于DIMM SPD	S-34C02B	5-11
2线串行E ² PROM用于DIMM SPD	S-34C04A	5-11
用于DIMM SPD 内置温度传感器 2线串行E ² PROM	S-34TS04A	5-12
EEPROM for SSD (VPD)		
内置温度传感器 2线串行E ² PROM	S-34TS04L	5-12
备有ARP功能 内置温度传感器 2线串行E ² PROM	S-585AA	5-13
CMOS IC封装		
封装一览表		5-14

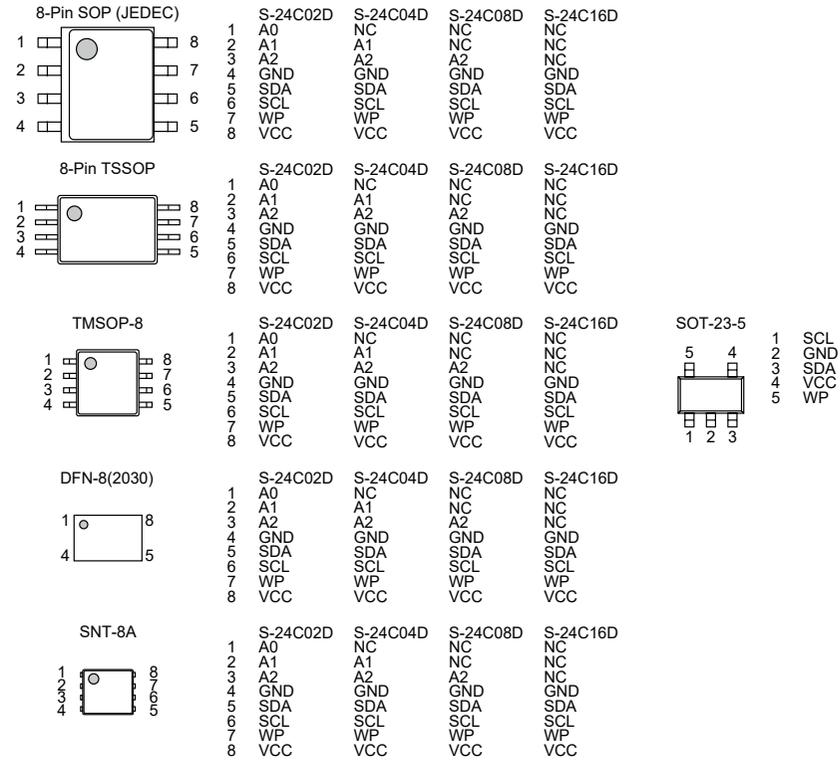
S-24C02D/04D/08D/16D

2 线串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围
 - 读出时: 1.7 V ~ 5.5 V
 - 写入时: 1.7 V ~ 5.5 V
- 工作频率: 1.0 MHz (最大值) ($V_{CC} = 2.5 V \sim 5.5 V$)
400 kHz (最大值) ($V_{CC} = 1.7 V \sim 5.5 V$)
- 写入时间: 5.0 ms (最大值)
- 页写入功能
 - S-24C02D: 8节 / 页
 - S-24C04D: 16节 / 页
 - S-24C08D: 16节 / 页
 - S-24C16D: 16节 / 页
- 顺序读出功能
- 噪声除去: 备有施密特触发器、
噪声滤波器输入端子 (SCL, SDA)
- 电源电压低时的禁止写入功能
- 重写次数: 10^6 次 / 字*1 ($T_a = +25 C$)
- 数据保存期: 100年 ($T_a = +25 C$)
- 存储器容量
 - S-24C02D: 2 K位
 - S-24C04D: 4 K位
 - S-24C08D: 8 K位
 - S-24C16D: 16 K位
- 写入保护: 100%
- 首次出厂时数据: FFh
- 工作温度范围: $T_a = -40 C \sim +85 C$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素

*1. 每个地址 (字: 8位)



S-24C32C/64C

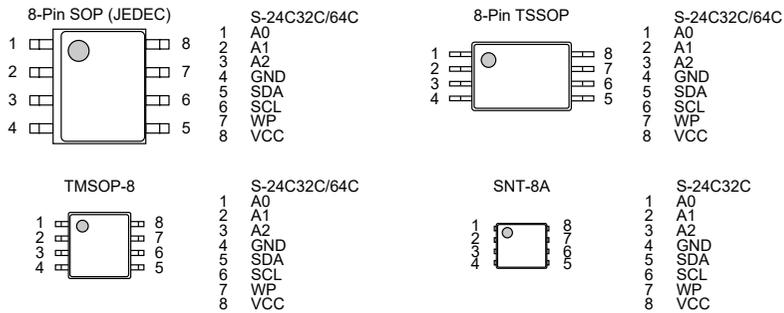
2 线串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围 读出时: 1.6 V ~ 5.5 V
写入时: 1.7 V ~ 5.5 V
32字节 / 页
- 页写入功能 :
- 顺序读出功能
- 工作频率 : 400 kHz ($V_{CC} = 1.6 V \sim 5.5 V$)
- 写入时间 : 5.0 ms (最大值)
- 噪声除去 : 备有施密特触发器、噪声滤波器输入端子(SCL, SDA)
- 低电源电压时禁止写入功能
- 重写次数 : 10^6 次 / 字^{*1} ($T_a = +25\text{ C}$ 时)
- 数据保存期 : 100年 ($T_a = +25\text{ C}$ 时)
- 存储器容量 : S-24C32C: 32 K位
S-24C64C: 64 K位
- 备有写入保护功能 : 100%
- 首次出厂数据 : FFh
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素^{*2}

*1. 每个地址 (字 : 8 位)

*2. 详情请参阅“■ 产品型号的构成”。



S-24C128C

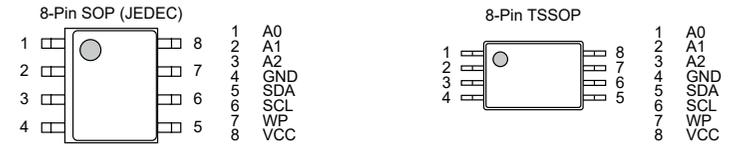
2 线串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围 读出时: 1.6 V ~ 5.5 V
写入时: 1.7 V ~ 5.5 V
64字节 / 页
- 页写入功能 :
- 顺序读出功能
- 工作频率 : 400 kHz ($V_{CC} = 1.6 V \sim 5.5 V$)
- 写入时间 : 5.0 ms (最大值)
- 噪声除去 : 备有施密特触发器、噪声滤波器输入端子 (SCL, SDA)
- 低电源电压时禁止写入功能
- 重写次数 : 10^6 次 / 字^{*1} ($T_a = +25\text{ C}$ 时)
- 数据保存期 : 100年 ($T_a = +25\text{ C}$ 时)
- 存储器容量 : 128 K位
- 备有写入保护功能 : 100%
- 首次出厂数据 : FFh
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素^{*2}

*1. 每个地址 (字 : 8 位)

*2. 详情请参阅“■ 产品型号的构成”。



S-24C256C

2 线串行E²PROM

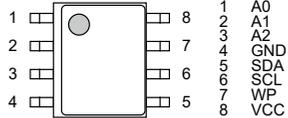
● 特点

- 工作电压范围 读出时： 1.6 V ~ 5.5 V
写入时： 1.7 V ~ 5.5 V
- 页写入功能： 64字节 / 页
- 顺序读出功能
- 工作频率： 1.0 MHz (V_{CC} = 2.5 V ~ 5.5 V)
400 kHz (V_{CC} = 1.6 V ~ 2.5 V)
- 写入时间： 5.0 ms (最大值)
- 噪声除去： 备有施密特触发器、噪声滤波器输入端子 (SCL, SDA)
- 低电源电压时禁止写入功能
- 重写次数： 10⁶次 / 组^{*1} (Ta = +25 C时)
- 数据保存期： 100年 (Ta = +25 C时)
- 存储器容量： 256 K位
- 备有写入保护功能： 100%
- 首次出厂数据： FFh
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素^{*2}

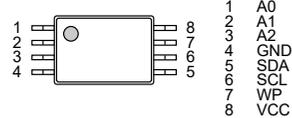
*1. 每个组 (组：具有相同的 W14 ~ W2 地址的 4 个字节)

*2. 详情请参阅“■ 产品型号的构成”。

8-Pin SOP (JEDEC)



8-Pin TSSOP



S-24C512C

2 线串行E²PROM

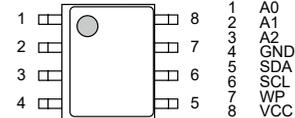
● 特点

- 工作电压范围 读出时： 1.6 V ~ 5.5 V
写入时： 1.7 V ~ 5.5 V
- 页写入功能： 128字节 / 页
- 顺序读出功能
- 工作频率： 1.0 MHz (V_{CC} = 2.5 V ~ 5.5 V)
400 kHz (V_{CC} = 1.6 V ~ 2.5 V)
- 写入时间： 5.0 ms (最大值)
- 噪声除去： 备有施密特触发器、噪声滤波器输入端子 (SCL, SDA)
- 低电源电压时禁止写入功能
- 重写次数： 10⁶次 / 组^{*1} (Ta = +25 C时)
- 数据保存期： 100年 (Ta = +25 C时)
- 存储器容量： 512 K位
- 备有写入保护功能： 100%
- 首次出厂数据： FFh
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素^{*2}

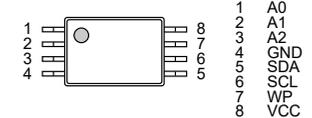
*1. 每个组 (组：具有相同的 W15 ~ W2 地址的 4 个字节)

*2. 详情请参阅“■ 产品型号的构成”。

8-Pin SOP (JEDEC)



8-Pin TSSOP



S-24CM01C

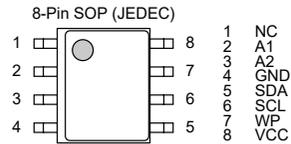
2 线串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围
读出时 : 1.6 V ~ 5.5 V
写入时 : 1.7 V ~ 5.5 V
- 页写入功能 : 256字节 / 页
- 顺序读出功能
- 工作频率 : 1.0 MHz ($V_{CC} = 2.5 V \sim 5.5 V$)
400 kHz ($V_{CC} = 1.6 V \sim 2.5 V$)
- 写入时间 : 5.0 ms (最大值)
- 噪声除去 : 备有施密特触发器、噪声滤波器输入端子 (SCL, SDA)
- 低电源电压时禁止写入功能
- 重写次数 : 10^6 次 / 组^{*1} ($T_a = +25\text{ C}$)
- 数据保存期 : 100年 ($T_a = +25\text{ C}$)
- 存储器容量 : 1 M位
- 备有写入保护功能 : 100%
- 首次出厂数据 : FFh
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素^{*2}

*1. 每个组 (组 : 具有相同的 P0, W15 ~ W2 地址的 4 个字节)

*2. 详情请参阅“■ 产品型号的构成”。



S-25C010A/020A/040A

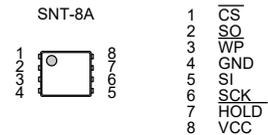
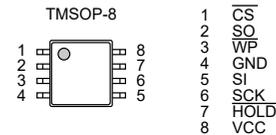
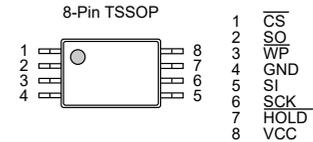
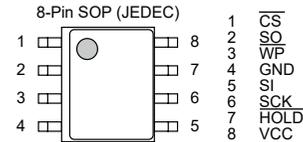
SPI 串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围 : 读出时 1.6 V ~ 5.5 V
写入时 1.7 V ~ 5.5 V
- 工作频率 : 5.0 MHz ($V_{CC} = 2.5 \sim 5.5 V$)
- 写入时间 : 4.0 ms (最大值)
- 支持SPI模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能 : 16字节 / 页
- 顺序读出功能
- 保护写入功能 : 软件、硬件
保护领域 : 25%, 50%, 100%
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时禁止写入功能
- CMOS施密特输入 (\overline{CS} , SCK, SI, \overline{WP} , \overline{HOLD})
- 重写次数 : 10^6 次 / 字^{*1} ($T_a = +25\text{ C}$)
- 数据保存期 : 100年 ($T_a = +25\text{ C}$)
- 存储器容量 : S-25C010A 1 K位
S-25C020A 2 K位
S-25C040A 4 K位
- 首次出厂时数据 : FFh, BP1 = 0, BP0 = 0
- 工作温度范围 : $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$
- 无铅、Sn 100%、无卤素^{*2}

*1. 每个地址 (字 : 8 位)

*2. 详情请参阅“■ 产品型号的构成”。



S-25C080A

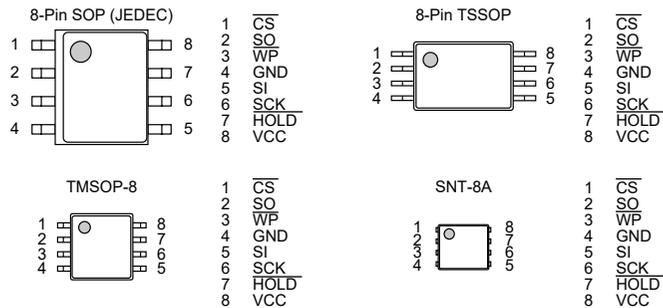
SPI 串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围： 读出时 1.6 V ~ 5.5 V
写入时 1.7 V ~ 5.5 V
- 工作频率： 5.0 MHz (V_{CC} = 2.5 V ~ 5.5 V)
- 写入时间： 4.0 ms (最大值)
- 支持SPI模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能： 32字节 / 页
- 顺序读出功能
- 写入保护功能： 软件、硬件
保护领域： 25%, 50%, 100%
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时的禁止写入功能
- CMOS施密特输入 (\overline{CS} , SCK, SI, \overline{WP} , \overline{HOLD})
- 重写次数： 10⁶次 / 字*1 (Ta = +25°C)
- 数据保存期： 100年 (Ta = +25°C)
- 存储器容量： 8 K位
- 首次出厂时数据： FFh, SRWD = 0, BP1 = 0, BP0 = 0
- 工作温度范围： Ta = -40°C ~ +85°C
- 无铅、Sn 100%、无卤素*2

*1. 每个地址 (字 : 8 位)

*2. 详情请参阅“■ 产品型号的构成”。



S-25C160A

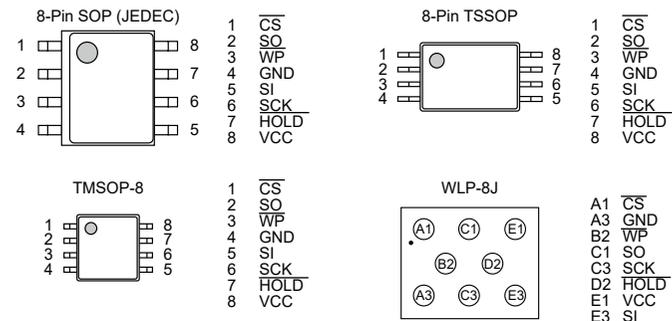
SPI 串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围： 读出时 1.6 V ~ 5.5 V
写入时 1.7 V ~ 5.5 V
- 工作频率： 5.0 MHz (V_{CC} = 2.5 V ~ 5.5 V)
- 写入时间： 5.0 ms (最大值)
- 支持SPI模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能： 32字节 / 页
- 顺序读出功能
- 写入保护功能： 软件、硬件
保护领域： 25%, 50%, 100%
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时的禁止写入功能
- CMOS施密特输入 (\overline{CS} , SCK, SI, \overline{WP} , \overline{HOLD})
- 重写次数： 10⁶次 / 字*1 (Ta = +25°C)
- 数据保存期： 100年 (Ta = +25°C)
- 存储器容量： 16 K位
- 首次出厂时数据： FFh, SRWD = 0, BP1 = 0, BP0 = 0
- 工作温度范围： Ta = -40°C ~ +85°C
- 无铅、Sn 100%、无卤素*2

*1. 每个地址 (字 : 8 位)

*2. 详情请参阅“■ 产品型号的构成”。



S-25C320A/640A

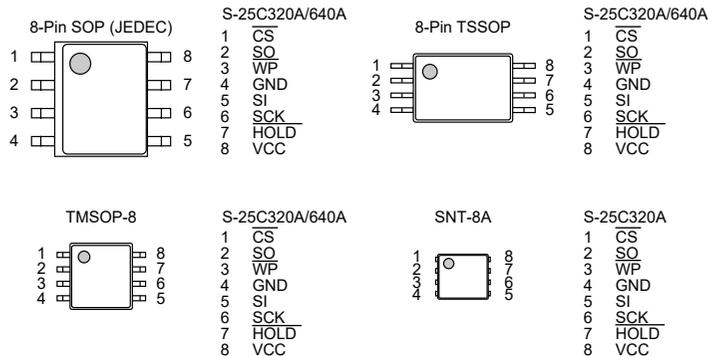
SPI 串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围：读出时 1.6 V ~ 5.5 V
写入时 1.7 V ~ 5.5 V
- 工作频率：5.0 MHz ($V_{CC} = 2.5 V \sim 5.5 V$)
- 写入时间：5.0 ms (最大值)
- 支持SPI模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能：32字节 / 页
- 顺序读出功能
- 写入保护功能：软件、硬件
- 保护领域：25%, 50%, 100%
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时的禁止写入功能
- CMOS施密特输入 (\overline{CS} , SCK, SI, \overline{WP} , \overline{HOLD})
- 重写次数： 10^6 次 / 字^{*1} ($T_a = +25\text{ C}$)
- 数据保存期：100年 ($T_a = +25\text{ C}$)
- 存储器容量：S-25C320A 32 K位
S-25C640A 64 K位
- 首次出厂时数据：FFh, SRWD = 0, BP1 = 0, BP0 = 0
- 工作温度范围： $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素^{*2}

*1. 每个地址 (字 : 8 位)

*2. 详情请参阅“■ 产品型号的构成”。



S-25C128A

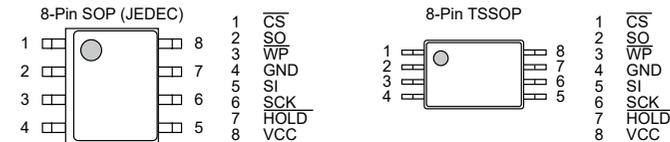
SPI 串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围：读出时 1.6 V ~ 5.5 V
写入时 1.7 V ~ 5.5 V
- 工作频率：5.0 MHz ($V_{CC} = 2.5 V \sim 5.5 V$)
- 写入时间：5.0 ms (最大值)
- 支持SPI模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能：64字节 / 页
- 顺序读出功能
- 写入保护功能：软件、硬件
- 保护领域：25%, 50%, 100%
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时的禁止写入功能
- CMOS施密特输入 (\overline{CS} , SCK, SI, \overline{WP} , \overline{HOLD})
- 重写次数： 10^6 次 / 字^{*1} ($T_a = +25\text{ C}$)
- 数据保存期：100年 ($T_a = +25\text{ C}$)
- 存储器容量：128 K位
- 首次出厂时数据：FFh, SRWD = 0, BP1 = 0, BP0 = 0
- 工作温度范围： $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素^{*2}

*1. 每个地址 (字 : 8 位)

*2. 详情请参阅“■ 产品型号的构成”。



S-25C256A

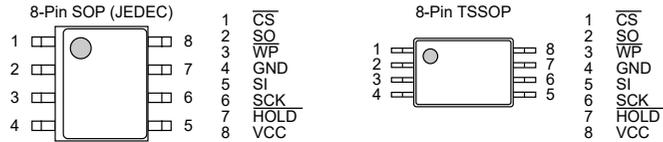
SPI 串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围：读出时 1.6 V ~ 5.5 V
写入时 1.7 V ~ 5.5 V
- 工作频率：10.0 MHz ($V_{CC} = 2.5 V \sim 5.5 V$)
- 写入时间：5.0 ms (最大值)
- 支持SPI模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能：64字节 / 页
- 顺序读出功能
- 写入保护功能：软件、硬件
- 保护领域：25%, 50%, 100%
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时的禁止写入功能
- CMOS施密特输入 (\overline{CS} , SCK, SI, \overline{WP} , \overline{HOLD})
- 重写次数：10⁶次 / 组^{*1} ($T_a = +25 C$)
- 数据保存期：100年 ($T_a = +25 C$)
- 存储器容量：256 K位
- 首次出厂时数据：FFh, SRWD = 0, BP1 = 0, BP0 = 0
- 工作温度范围： $T_a = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素^{*2}

*1. 每个组 (组：具有相同的A14 ~ A2地址的4个字节)

*2. 详情请参阅“■ 产品型号的构成”。



S-25C512A

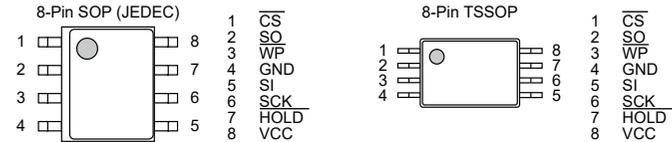
SPI 串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围：读出时 1.6 V ~ 5.5 V
写入时 1.7 V ~ 5.5 V
- 工作频率：10.0 MHz ($V_{CC} = 2.5 V \sim 5.5 V$)
- 写入时间：5.0 ms (最大值)
- 支持SPI模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能：128字节 / 页
- 顺序读出功能
- 写入保护功能：软件、硬件
- 保护领域：25%, 50%, 100%
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时的禁止写入功能
- CMOS施密特输入 (\overline{CS} , SCK, SI, \overline{WP} , \overline{HOLD})
- 重写次数：10⁶次 / 组^{*1} ($T_a = +25 C$)
- 数据保存期：100年 ($T_a = +25 C$)
- 存储器容量：512 K位
- 首次出厂时数据：FFh, SRWD = 0, BP1 = 0, BP0 = 0
- 工作温度范围： $T_a = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素^{*2}

*1. 每个组 (组：具有相同的A15 ~ A2地址的4个字节)

*2. 详情请参阅“■ 产品型号的构成”。



S-25CM01A

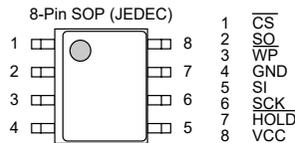
SPI 串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围 : 读出时 1.6 V ~ 5.5 V
写入时 1.7 V ~ 5.5 V
- 工作频率 : 10.0 MHz (V_{CC} = 2.5 V ~ 5.5 V)
- 写入时间 : 5.0 ms (最大值)
- 支持SPI模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能 : 256字节 / 页
- 顺序读出功能
- 写入保护功能 : 软件、硬件
- 保护领域 : 25%, 50%, 100%
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时的禁止写入功能
- CMOS施密特输入 (\overline{CS} , SCK, SI, \overline{WP} , \overline{HOLD})
- 重写次数 : 10⁶次 / 组^{*1} (Ta = +25 C)
- 数据保存期 : 100年 (Ta = +25 C)
- 存储器容量 : 1 M位
- 首次出厂时数据 : FFh, SRWD = 0, BP1 = 0, BP0 = 0
- 工作温度范围 : Ta = -40°C ~ +85°C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素^{*2}

*1. 每个组 (组 : 具有相同的A16 ~ A2地址的4个字节)

*2. 详情请参阅 "■ 产品型号的构成"。



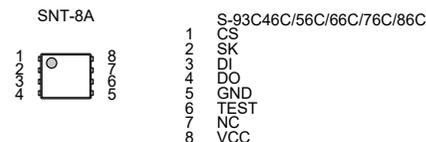
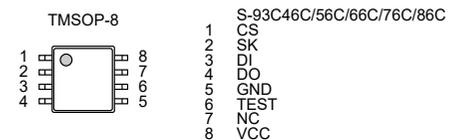
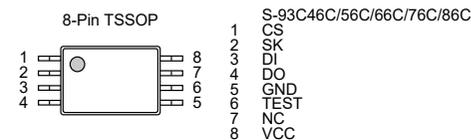
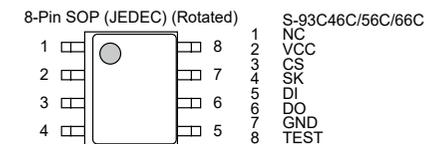
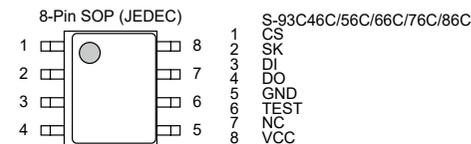
S-93C46C/56C/66C/76C/86C

3线串行E²PROM

● 特点

- 存储器容量 : S-93C46C : 1 K位 (64字 × 16位)
S-93C56C : 2 K位 (128字 × 16位)
S-93C66C : 4 K位 (256字 × 16位)
S-93C76C : 8 K位 (512字 × 16位)
S-93C86C : 16 K位 (1024字 × 16位)
- 工作电压范围 : 读出时 : 1.6 V ~ 5.5 V
写入时 : 1.8 V ~ 5.5 V
- 工作频率 : 2.0 MHz (最大值)
- 写入时间 : 4.0 ms (最大值)
- 顺序读出功能
- 电源电压低时禁止写入功能
- 指令误识别的防止写入功能
- 重写次数 : 10⁶次 / 字^{*1} (Ta = +85 C)
- 数据保存期 : 100年 (Ta = +25 C)
50年 (Ta = +85 C)
- 首次出厂时数据 : FFFFh
- 工作温度范围 : Ta = -40 C ~ +85 C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素

*1. 每个地址 (字 : 16位)



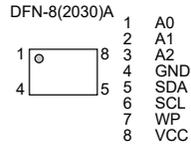
S-34C02B

2线串行E²PROM
用于DIMM SPD

● 特点

- 工作电压范围
 - 读出 : 1.7 V ~ 5.5 V
 - 写入 : 1.7 V ~ 5.5 V
- 工作频率 : 400 kHz (最大值) ($V_{CC} = 1.7 V \sim 5.5 V$)
- 写入时间 : 5.0 ms (最大值)
- 页写入 : 16节 / 页
- 顺序读出
- 噪声除去 : 备有施密特触发器、噪声滤波器输入端子 (SCL, SDA)
- 电源电压低时的禁止写入功能
- 重写次数 : 10^6 次 / 字*1 ($T_a = +25^{\circ}C$)
- 数据保存期 : 100年 ($T_a = +25^{\circ}C$)
- 存储器容量 : 2 K位
- 首次出厂时数据 : FFh
- 工作温度范围 : $T_a = -40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
- 写入保护 :
 - 硬件保护 100% (地址00h ~ FFh)
 - 软件保护 地址下位50% (地址00h ~ 7Fh)
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素

*1. 每个地址 (字 : 8位)



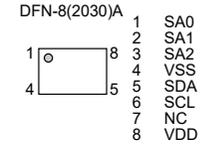
S-34C04A

2线串行E²PROM
用于DIMM SPD

● 特点

- 页写入 : 16节 / 页
- 顺序读出
- 电源电压低时的禁止写入功能
- 写入保护 : 可按每4块 (128字节 / 块) 设置软件保护
- 重写次数 : 10^6 次 / 字*1 ($T_a = +25^{\circ}C$)
- 数据保存期 : 100年 ($T_a = +25^{\circ}C$)
- 存储器容量 : 4 K位
- 首次出厂时数据 : FFh
- 遵从JEDEC规范 : EE1004-1
- 消耗电流
 - 待机模式 : 3.0 μ A (最大值)
 - 读出模式 : 0.4 mA (最大值)
 - 写入模式 : 2.0 mA (最大值)
- 工作电压范围 : 1.7 V ~ 3.6 V
- 工作频率 : 1.0 MHz (最大值) ($V_{DD} = 2.2 V \sim 3.6 V$)
400 kHz (最大值) ($V_{DD} = 1.7 V \sim 3.6 V$)
- 噪声除去 : 备有施密特触发器、带噪声滤波器输入端子 (SCL, SDA)
- 工作温度范围 : $T_a = -20^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素

*1. 每个地址 (字 : 8位)



用于DIMM SPD
内置温度传感器 2线串行E²PROM

S-34TS04A

● 特点

E²PROM部分

- 页写入 : 16节 / 页
- 顺序读出
- 电源电压低时的禁止写入功能
- 写入保护 : 可按每4块 (128字节 / 块) 设置软件保护
- 重写次数 : 10⁶次 / 字*1 (Ta = +25°C)
- 数据保存期 : 100年 (Ta = +25°C)
- 存储器容量 : 4 K位
- 首次出厂时数据 : FFh

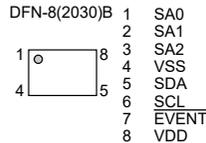
温度传感器部分

- 温度精度 : 0.5°C (典型值) (Ta = +75°C ~ +95°C)
1.0°C (典型值) (Ta = +40°C ~ +125°C)
- 温度测定频率 : 8次 / 秒 (最小值)
- 可选择滞后幅度 : 无滞后、1.5°C、3.0°C、6.0°C

整体

- 遵从JEDEC规范 : TSE2004B2
- 消耗电流 :
E²PROM待机模式、温度传感器休眠模式 : 3.0 μA (最大值)
E²PROM待机模式、温度传感器工作模式 : 0.1 mA (最大值)
E²PROM读出模式、温度传感器工作模式 : 0.4 mA (最大值)
E²PROM写入模式、温度传感器工作模式 : 2.0 mA (最大值)
- 工作电压范围 : 2.2 V ~ 3.6 V
- 工作频率 : 1.0 MHz (最大值) (V_{DD} = 2.2 V ~ 3.6 V)
- 噪声除去 : 备有施密特触发器、带噪声滤波器输入端子 (SCL, SDA)
- 工作温度范围 : Ta = -20°C ~ +125°C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素

*1. 每个地址 (字 : 8位)



内置温度传感器
2线串行E²PROM

S-34TS04L

● 特点

E²PROM部分

- 页写入 : 16节 / 页
- 顺序读出
- 电源电压低时的禁止写入功能
- 写入保护 : 可按每4块 (128字节 / 块) 设置软件保护
- 重写次数 : 10⁶次 / 字*1 (Ta = +25°C)
- 数据保存期 : 100年 (Ta = +25°C)
- 存储器容量 : 4 K位
- 首次出厂时数据 : FFh

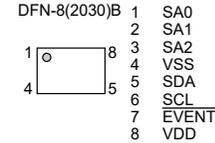
温度传感器部分

- 温度精度 : 0.5°C (典型值) (Ta = +75°C ~ +95°C)
1.0°C (典型值) (Ta = +40°C ~ +125°C)
- 温度测定频率 : 8次 / 秒 (最小值)
- 可选择滞后幅度 : 无滞后、1.5°C、3.0°C、6.0°C

整体

- 消耗电流 :
E²PROM待机模式、温度传感器休眠模式 : 3.0 μA (最大值)
E²PROM待机模式、温度传感器工作模式 : 0.1 mA (最大值)
E²PROM读出模式、温度传感器工作模式 : 0.4 mA (最大值)
E²PROM写入模式、温度传感器工作模式 : 2.0 mA (最大值)
- 工作电压范围 : 1.7 V ~ 3.6 V
- 工作频率 : 1.0 MHz (最大值) (V_{DD} = 2.2 V ~ 3.6 V)
- 噪声除去 : 备有施密特触发器、带噪声滤波器输入端子 (SCL, SDA)
- 辅助SMBus超时功能
- 工作温度范围 : Ta = -20°C ~ +125°C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素

*1. 每个地址 (字 : 8位)



S-585AA

备有ARP功能
内置温度传感器
2线串行E²PROM

● 特点

E²PROM部分

- 页写入 : 16节 / 页
- 顺序读出
- 电源电压低时的禁止写入功能
- 写入保护 : 可按每4块 (128字节 / 块) 设置软件保护
- 重写次数 : 10⁶次 / 字*1 (Ta = +25°C)
- 数据保存期 : 100年 (Ta = +25°C)
- 存储器容量 : 4 K位
- 首次出厂时数据 : FFh

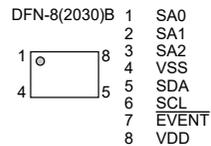
温度传感器部分

- 温度精度 : ±0.25°C (典型值) / ±1.0°C (最大值) (Ta = 0°C ~ +85°C)
±0.25°C (典型值) / ±1.5°C (最大值) (Ta = -40°C ~ +125°C)
- 温度测定频率 : 8次 / 秒 (最小值)
- 可选择滞后幅度: 无滞后、1.5°C、3.0°C、6.0°C

整体

- 辅助SMBus的ARP功能
- 辅助报警响应地址 (ARA) 功能
- 辅助默认从属地址 (DSA)
- 消耗电流 :
E²PROM待机模式、温度传感器休眠模式 : 3.0 μA (最大值)
E²PROM待机模式、温度传感器工作模式 : 0.1 mA (最大值)
E²PROM读出模式、温度传感器工作模式 : 0.4 mA (最大值)
E²PROM写入模式、温度传感器工作模式 : 2.0 mA (最大值)
- 工作电压范围 : 1.7 V ~ 3.6 V
- 工作频率 : 1.0 MHz (最大值) (V_{DD} = 2.2 V ~ 3.6 V)
400 kHz (最大值) (V_{DD} = 1.7 V ~ 3.6 V)
- 噪声除去 : 备有施密特触发器、带噪声滤波器输入端子 (SCL, SDA)
- 工作温度范围 : Ta = -40°C ~ +125°C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素

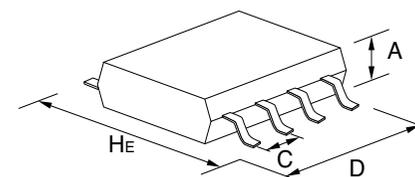
*1. 每个地址 (字 : 8位)



封装类型	引脚数	封装名称	封装尺寸 (mm)			间距 (mm)
			He	D	A (max.)	C
引线插入型	3	TO-92	7.0	5.2	4.2	2.5/1.27
	3	TO-92S	4.95	4.1	1.62	2.5/1.27
扁平引线型	3	SOT-89-3	4.0	4.5	1.6	1.5
	5	SOT-89-5	4.5	4.5	1.6	1.5
双翅型	4	SC-82AB	2.1	2.0	1.1	1.3
	5	SC-88A	2.1	2.0	1.1	0.65
	3	SOT-23-3	2.8	2.9	1.3	1.9
	3	SOT-23-3S	2.8	2.9	1.2	1.9
	3	TSOT-23-3S	2.85	2.9	0.8	1.9
	5	SOT-23-5	2.8	2.9	1.3	0.95
	6	SOT-23-6	2.8	2.9	1.35	0.95
	6	SOT-23-6W	2.8	2.9	1.3	0.95
	8	8-Pin SOP (JEDEC)	6.0	5.02	1.75	1.27
	8	8-Pin TSSOP	6.4	3.0	1.1	0.65
	8	8-Pin TSSOP	6.4	3.0	1.1	0.65
	16	16-Pin TSSOP	6.4	5.1	1.1	0.65
	20	20-Pin TSSOP	6.4	6.5	1.2	0.65
	24	24-Pin SSOP	7.6	7.9	1.4	0.65
	8	TMSOP-8	4.0	2.9	0.8	0.65
	8	HTMSOP-8	4.0	2.9	0.8	0.65
	16	HTSSOP-16	6.4	5.12	1.1	0.65
	6	HSOP-6	6.0	5.02	1.75	1.91
	8	HSOP-8A	6.0	5.02	1.68	1.27
	8	HSOP-8A	6.0	5.02	1.65	1.27
	8	HSOP-8Q	6.0	5.02	1.68	1.27
	5	TO-252-5S(A)	6.5	6.5	1.4	1.27
	9	TO-252-9S	6.5	6.5	1.4	0.65

封装类型	引脚数	封装名称	封装尺寸 (mm)			间距 (mm)
			He	D	A (max.)	C
无引线型	6	6-Pin HSON(A)	3.0	2.9	0.9	0.95
	6	SON-6C	2.55	1.56	0.65	0.5
	4	SNT-4A	1.6	1.2	0.5	0.65
	6	SNT-6A SNT-6A(H)	1.8	1.57	0.5	0.5
	8	SNT-8A	2.46	1.97	0.5	0.5
	4	HSNT-4(0808)	0.8	0.8	0.4	0.4
	4	HSNT-4(0808)B	0.8	0.8	0.41	0.4
	4	HSNT-4(1010)	1.0	1.0	0.4	0.65
	4	HSNT-4(1010)B	1.0	1.0	0.41	0.65
	6	HSNT-6A	2.46	1.96	0.5	0.5
	6	HSNT-6(1212)	1.2	1.2	0.4	0.4
	6	HSNT-6D (HSNT-6(1618))	1.8	1.6	0.4	0.5
	6	HSNT-6(2025)	2.46	1.96	0.5	0.5
	8	HSNT-8(1616)	1.6	1.6	0.4	0.4
	8	HSNT-8(2030)	3.0	2.0	0.5	0.5
	6	DFN-6(1414)A	1.4	1.4	0.6	0.5
	6	DFN-6(1518)A	1.8	1.5	0.33	0.5
	8	DFN-8(1616)A	1.6	1.6	0.6	0.4
	8	DFN-8(2030)	3.0	2.0	0.5	0.5
	8	DFN-8(2030)A	3.0	2.0	0.6	0.5
8	DFN-8(2030)B	3.0	2.0	0.8	0.5	

备注 有关详细的WLP封装产品, 请向代理商咨询。



注意事项

- 本产品目录有可能未经预告而更改内容。
- 未经本公司许可，严禁将本产品目录的一部分或全部内容进行转载、复制等来用于其他目的。
- 本产品目录所登载的产品照片由于是印刷品，与实际产品相比，色彩可能稍有偏差。使用时请事先确认。
- 本产品目录上所登载的电路和使用方法仅供参考。对因这些资料所引起的对第三者的权利（包括知识产权）的侵犯或损害，本公司不予以任何保证。另外，本产品目录并非是对第三者或本公司的知识产权的实施权的许可。
- 本产品目录所登载产品，如果属于“外汇及外国贸易法”所规定的限制货物（或劳务），则必须取得该法规所规定的出口许可。
- 本产品目录所登载的产品未经本公司书面许可，不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯关联器械、车辆器械、车载器械、航空器械、太空器械及核电关联器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
- 本产品目录所记载的产品，非耐放射线设计产品。
- 本公司已为提高品质、可靠性作了最大的努力，但是半导体产品有可能按照一定的概率发生故障或错误工作。为防止因故障或错误工作而产生的人身事故、火灾事故和社会损害等，请用户在安全设计上予以足够的重视，采取诸如冗余设计、延烧对策设计和防止错误工作设计等措施。



更小型。更节能。更安全方便。

具备以钟表制造业培育的低消耗电流、低电压工作和超小型封装技术。拥有满足严格的车载基准、高质量及高信赖性的精湛工艺。艾普凌科有限公司的半导体解决方案为世界带来超越客户及社会期待的感动。



艾普凌科有限公司

www.ablic.com

咨询处

www.ablic.com/en/semicon/sales/



2023年3月发行

艾普凌科有限公司是美蓓亚三美株式会社集团公司的成员。



本目录内容在改进产品时，有可能未经预告而有所更改。